LIGHT EMITTING DEVICE AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Patent number:

JP2004265691

Publication date:

2004-09-24

Inventor:

YAMAZAKI SHUNPEI; GOTO HIROMITSU; SAKATA

JUNICHIRO; TSUCHIYA KAORU

Applicant:

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Classification:

- international:

H05B33/12; G09G3/30; H01J1/62; H01J63/04; H01L27/32; H01L51/50; H01L51/52; H05B33/14; H05B33/28; H05B33/12; G09G3/30; H01J1/00; H01J63/00; H01L27/28; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/26; (IPC1-7): H05B33/12; H05B33/14;

H05B33/28

- european:

H01L27/32C4; H01L27/32C6; H01L51/52D

Application number: JP20030053944 20030228 Priority number(s): JP20030053944 20030228

Report a data error here

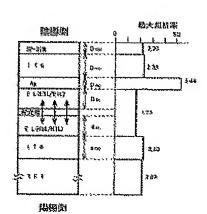
Also published as:

US2004169624 (A1)

Abstract of JP2004265691

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that a difference in optical characteristic (such as color tone) occurs by light emission from a top surface and light emission from a bottom surface due to an interference effect from the difference in optical distance when the material of a cathode and an anode is translucent, and translucent material is used for substrate and sealing substrate, even though 2 types of display can be performed simultaneously in light emission passing through the cathode and light emission passing through the anode. SOLUTION: In the light emitting device provided with light emission from the top surface and the light emission from the bottom surface, by adjusting the film thickness of a transparent conductive film provided on a cathode side and the film thickness of the cathode, color tone in light emission to the top surface and the light emission to the bottom surface can be made uniform and a high quality image display is obtained.

COPYRIGHT: (C)2004.JPO&NCIPI



Family list

2 family members for: JP2004265691

Derived from 2 applications

1 LIGHT EMITTING DEVICE AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI; GOTO HIROMITSU; Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

(+2)

EC: H01L27/32C4; H01L27/32C6; (+1)

IPC: H05B33/12; G09G3/30; H01J1/62 (+17)

Publication info: JP2004265691 A - 2004-09-24

2 Light emitting device and electric appliance

Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI (JP); GODO

Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (US)

HIROMICHI (JP); (+2)

EC: H01L27/32C4; H01L27/32C6; (+1)

IPC: H05B33/12; G09G3/30; H01J1/62 (+17)

Publication info: US2004169624 A1 - 2004-09-02

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

JP 2004-265691 A 2004.9.24

(11)特許出願公開番号

特開2004-265691

(P2004-265691A) (43)公開日 平成16年9月24日(2004.9.24)

(51) Int. Cl. ⁷ F I テーマコード(参考)

H 0 5 B 33/12 Z 3 K 0 0 7 H 0 5 B 33/14 H 0 5 B 33/12 E H 0 5 B 33/28 H 0 5 B 33/28 A H 0 5 B 33/28

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全14頁)

(21) 出願番号 特願2003-53944 (P2003-53944) (71) 出願人 000153878 (22) 出願日 平成15年2月28日 (2003.2.28) 株式会社半導を

|2) 出願日 平成15年2月28日(2003.2.28) 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地

> (72)発明者 山崎 舜平 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社

> > 半導体エネルギー研究所内

(72)発明者 郷戸 宏充

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社

半導体エネルギー研究所内

(72)発明者 坂田 淳一郎

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社

半導体エネルギー研究所内

(72)発明者 土屋 薫

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社

半導体エネルギー研究所内

最終頁に続く

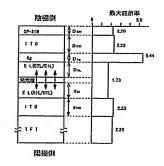
(54) 【発明の名称】発光装置および電子機器

(57)【要約】

【課題】陰極および陽極の材料を透光性とし、基板や封止基板として透光性のものを用いた場合、有機化合物を含む層からの発光は、陰極を通過する発光と、陽極を透過する発光との2通りの表示が同時に行える。しかし、光学距離の違いによる干渉効果のため上面からの発光と下面からの発光とで光学特性(色調など)に差を生ずる

【解決手段】本発明は、上面からの発光と下面からの発光とを有する発光装置において、陰極側に設ける透明導電膜の膜厚と、陰極の膜厚とを調節することによって、上面への発光および下面への発光ともに色調が均一、且つ、高品質な画像表示を得る。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

透光性である第1の電極と、該第1の電極上に接する有機化合物を含む層と、該有機化合 物を含む層上に接する透光性である第2の電極とを有する発光素子を複数有する画素部を 備えた発光装置であって、

赤、緑、或いは青の3種類の発光素子を有し、

第1の電極を通過する発光と、第2の電極を通過する発光との両方において、赤、緑、青 の3色の発光が色座標に同一の三角形を形成することを特徴とする発光装置。

【請求項2】

透光性である第1の電極と、該第1の電極上に接する有機化合物を含む層と、該有機化合 10 物を含む層上に接する透光性である第2の電極とを有する発光素子を複数有する画素部を 備えた発光装置であって、

白色の発光素子とカラーフィルタとを有し、

第 1 の 電 極 を 通 過 す る 発 光 と 、 第 2 の 電 極 を 通 過 す る 発 光 と の 両 方 に お い て 、 カ ラ ー フィ ルタを透過した3色の透過光が色座標に同一の三角形を形成することを特徴とする発光装 置。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、前記第1の電極および前記第2の電極は、有機化合物 を含む層を発光層とする発光素子の陰極、或いは陽極であることを特徴とする発光装置。

【請求項4】

請 求 項 1 乃 至 3 の い ず れ か 一 に お い て 、 前 記 第 1 の 電 極 を 透 過 す る 光 と 、 前 記 第 2 の 電 極 を透過する光とで通過する層数が異なることを特徴とする発光装置。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれか一において、前記第1の電極、或いは前記第2の電極にTFT が接続されていることを特徴とする発光装置。

【請求項6】

請 求 項 1 乃 至 5 の い ず れ か 一 に お い て 、 前 記 第 1 の 電 極 ま た は 前 記 第 2 の 電 極 は 、 透 明 導 電膜、または、光を透過する金属薄膜であることを特徴とする発光装置。

【請求項7】

請 求 項 1 乃 至 6 の い ず れ か 一 に お い て 、 前 記 発 光 装 置 は 、 ビ デ オ カ メ ラ 、 デ ジ タ ル カ メ ラ 、 カ ー ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 、 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 、 ま た は 携 帯 情 報 端 末 で あ る こ と を 特 徴 とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】

本 発 明 は 、 一 対 の 電 極 間 に 有 機 化 合 物 を 含 む 膜 (以 下 、 「 有 機 化 合 物 層 」 と 記 す) を 設 け た素子に電界を加えることで、蛍光又は燐光が得られる発光素子を用いた発光装置及びそ の作製方法に関する。なお、本明細書中における発光装置とは、画像表示デバイス、発光 デバイス、もしくは光源(照明装置含む)を指す。また、発光装置にコネクター、例えば FPC (Flexible printed circuit) もしくはTAB (Tap e Automated Bonding) テープもしくはTCP(Tape Carr Package)が取り付けられたモジュール、TABテープやTCPの先にプ リント配線板が設けられたモジュール、または発光素子にCOG(Chip On ass)方式によりIC(集積回路)が直接実装されたモジュールも全て発光装置に含む ものとする。

[0002]

【従来の技術】

近年、自発光型の発光素子としてEL素子を有した発光装置の研究が活発化している。こ の発光装置は有機ELディスプレイ、又は有機発光ダイオードとも呼ばれている。これら の発光装置は、動画表示に適した速い応答速度、低電圧、低消費電力駆動などの特徴を有 50

30

40

し て い る た め 、 新 世 代 の 携 帯 電 話 や 携 帯 情 報 端 末 (P D A) を は じ め 、 次 世 代 デ ィ ス プ レ イとして大きく注目されている。

[0003]

なお、EL素子は、電場を加えることで発生するルミネッセンス (Electro Lu minescence)が得られる有機化合物を含む層(以下、EL層と記す)と、陽極 と、陰極とを有する。有機化合物におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底 状態に戻る際の発光(蛍光)と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光(リン光)と があるが、本発明の成膜装置および成膜方法により作製される発光装置は、どちらの発光 を用いた場合にも適用可能である。

[0004]

発光装置は、液晶表示装置と異なり自発光型であるため視野角の問題がないという特徴が ある。即ち、屋外に用いられるディスプレイとしては、液晶ディスプレイよりも適してお り、様々な形での使用が提案されている。

[0005]

また、本明細書中では、陰極、EL層及び陽極で形成される発光素子をEL素子といい、 これには、互いに直交するように設けられた2種類のストライプ状電極の間にEL層を形 成する方式(単純マトリクス方式)、又はTFTに接続されマトリクス状に配列された画 素 電 極 と 対 向 電 極 と の 間 に E L 層 を 形 成 す る 方 式 (ア ク テ ィ ブ マ ト リ ク ス 方 式) の 2 種 類 がある。しかし、画素密度が増えた場合には、画素(又は1ドット)毎にスイッチが設け られているアクティブマトリクス型の方が低電圧駆動できるので有利であると考えられて 20 いる。

[0006]

従来、 E L 層から得られる光の所定の波長がピーク波長となるように、 陽極および複数の 有 機 化 合 物 を 含 む 層 の 厚 み を 設 定 し た 有 機 E L 素 子 が 、 例 え ば 特 許 文 献 1 に 開 示 さ れ て い

[0007]

【特許文献1】

特許第2846571号

[0008]

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

陰極および陽極の材料を透光性とし、基板や封止基板として透光性のものを用いた場合、 有機化合物を含む層からの発光は、陰極を通過する発光と、陽極を透過する発光との2通 りの表示が同時に行える。

[0009]

しかし、光学距離の違いによる干渉効果のため上面からの発光と下面からの発光とで光学 特性(色調など)に差を生ずる。陰極および陽極の材料を透光性とした、赤、緑、青の3 種類の発光素子(EL素子)を用いてフルカラーの発光表示装置を作製した場合、図8に 示すように色座標が上面からの発光と、下面からの発光とで異なってしまう問題がある。 色座標が異なると、上面と下面とで同じ階調表示を行うことが不可能となる。

[0010]

光 学 距 離 は 各 波 長 に よ っ て 異 な る た め 、 フ ル カ ラ ー の 場 合 に は R G B で そ れ ぞ れ 有 機 化 合 物を含む層、陽極、陰極、保護膜などの膜厚を制御する必要がある。

[0011]

本発明は、陰極および陽極の材料を透光性とした発光素子(EL素子)において、上面へ の発光および下面への発光ともに色調が均一、且つ、高品質な画像表示が得られる発光装 置を提供する。

[0012]

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

上記課題を解決するため、本発明は、陰極および陽極の材料を透光性とした3つの発光素 子(赤、緑、青)から陰極を透過する発光と、陽極を透過する発光とを有する発光装置に 50

おいて、

陰極を透過した発光と陽極を透過した発光とがそれぞれ色座標において同一となることを 特徴とする発光装置である。

[0013]

陰極および陽極を透過する発光は、さまざまな層または基板を通過する。例えば、アクティブマトリクス型の発光装置の場合、陰極側あるいは陽極側にTFTなどのスイッチング素子を設けるため、陰極側あるいは陽極側にTFTの層間絶縁膜(窒化シリコン膜や有機樹脂膜)などが形成されるため、発光点から通過させる積層数が異なる。また、封止基板が貼り合わされている場合には、発光点から封止基板表面までの距離と、発光点から素子基板までの距離も異なる。これらの要因によって発光の色調が異なる。

[0014]

本発明は、透明導電膜の膜厚と陰極の膜厚とを調節することによって、上面への発光および下面への発光ともに色調が均一、且つ、高品質な画像表示が得られる発光装置を実現する。

[0015]

本明細書で開示する発明の構成は、

透光性である第1の電極と、該第1の電極上に接する有機化合物を含む層と、該有機化合物を含む層上に接する透光性である第2の電極とを有する発光素子を複数有する画素部を備えた発光装置であって、

赤、緑、或いは青の3種類の発光素子を有し、

第1の電極を通過する発光と、第2の電極を通過する発光との両方において、赤、緑、青の3色の発光が色座標に同一の三角形を形成することを特徴とする発光装置である。

[0016]

また、本発明は、3種類の発光素子を用いたフルカラー表示の発光装置に限定されず、他の発明の構成は、

透光性である第1の電極と、該第1の電極上に接する有機化合物を含む層と、該有機化合物を含む層上に接する透光性である第2の電極とを有する発光素子を複数有する画素部を備えた発光装置であって、

白色の発光素子とカラーフィルタとを有し、

第1の電極を通過する発光と、第2の電極を通過する発光との両方において、カラーフィ 30 ルタを透過した3色の透過光が色座標に同一の三角形を形成することを特徴とする発光装置である。

[0017]

また、青色の発光素子と色変換層とを用いてもよく、他の発明の構成は、

透光性である第1の電極と、該第1の電極上に接する有機化合物を含む層と、該有機化合物を含む層上に接する透光性である第2の電極とを有する発光素子を複数有する画素部を備えた発光装置であって、

青色の発光素子と色変換層とを有し、

第1の電極を通過する発光と、第2の電極を通過する発光との両方において、色変換層を透過した赤色および緑色の透過光と、青色の発光とが色座標に同一の三角形を形成するこ 40とを特徴とする発光装置である。

[0018]

また、上記各構成において、前記第1の電極および前記第2の電極は、有機化合物を含む層を発光層とする発光素子の陰極、或いは陽極であることを特徴としている。

[0019]

また、上記各構成において、前記第1の電極を透過する光と、前記第2の電極を透過する 光とで通過する層数が異なることを特徴としている。アクティブマトリクス型の場合、一方の基板にはTFTが形成されており、TFTの層間絶縁膜やゲート絶縁膜や保護膜などを光は通過することになる。また、前記第1の電極、或いは前記第2の電極にTFTが接続されている。

20

[0020]

また、上記各構成において、前記第1の電極または前記第2の電極は、透明導電膜、または、光を透過する金属薄膜であることを特徴としている。

[0021]

また、図 6 に示すように、両面発光する発光装置において、発光パネルを挟んで光の偏光 方向が直交するように 2 枚の偏光板を配置し、一方の面から見た場合に、背景が透けて見 えて表示を認識しにくくなることを防ぐことができる。

[0022]

【発明の実施の形態】

本発明の実施形態について、以下に説明する。

10

[0023]

図1に示す積層モデルを用いてシミュレーションを行った。

[0024]

本発明者らは、3種類(R, G、B)のEL素子に共通する層の膜厚、即ち、陰極となる金属薄膜の膜厚と、その上に形成する透明導電膜の膜厚とを調節することにより、上面からの発光と下面からの発光との色調を同一にできることを見出し、本発明に到った。

[0025]

図1に示すようにITOの陽極、発光層を含む複数の有機化合物を含む層(EL層)、金属薄膜(Ag)の陰極、ITOの透明電極、SiNの保護膜を順次積層したEL素子において、EL層は発光層の発光界面を境にして陰極側と陽極側とに分けられる。なお、波長 20によって材料の屈折率は異なっており、図1では最大屈折率の値を示している。

[0026]

発光層の発光界面から陽極に向かう光は、陽極と、TFTを含む層と、透明基板とを通過して外部発光に寄与する。また、発光層の発光界面から陰極に向かう光も、金属薄膜と、透明電極と、保護膜と、空隙と、透明基板とを通過して外部発光に寄与する。

[0027]

A g からなる金属薄膜とEL層の屈折率段差と、A g からなる金属薄膜と透明電極の屈折率段差は、他の隣接層の屈折率差よりも格段に大きい。本発明は、この金属薄膜と透明電極の膜厚を調節して陰極側からの発光と陽極側からの発光とを合わせる。

[0028]

30

フルカラー表示するため、3つの発光素子から得られる発光は、620nmにピークを有する赤色発光素子と、530nmにピークを有する緑色発光素子と、450nmにピークを有する青色発光素子とを用いると仮定する。実際、EL素子からの発光は急峻なピークではなく、幅のひろいピークを示す。

[0029]

この3つの波長域(620nm、530nm、450nm)において、上面からの発光と、下面からの発光との透過率、反射率、および吸収率をそれぞれシミュレーションにより求めると、陰極となる金属薄膜としてAgを用いる場合、6nm~10nm、代表的には8nmとし、その上の透明導電層(ITO)を240nm~290nm、380nm~50nm、代表的には260nmとすると、R、G、Bのそれぞれにおいて、上面からの40発光と下面からの発光との透過率、反射率、および吸収率をほぼ同一にできる。

[0030]

こうして、本発明により、上面への発光および下面への発光ともに色調が均一、且つ、高品質な画像表示が得られる。

[0031]

なお、EL層は、陽極側から順に、HIL(ホール注入層)、HTL(ホール輸送層)、EML(発光層)、ETL(電子輸送層)、EIL(電子注入層)の順に積層する。具体的には、HILとしてCuPc、HTLとして α -NPD、ETLとしてBCP、EILとしてBCP:Liをそれぞれ用いる。なお、EMLは、R、G、Bのそれぞれの発光色に対応したドーパントをドープしたAl q 。を用いればよい。

20

30

[0032]

なお、Agの膜厚が5nm以下になると電気抵抗率が高くなってしまう。また、Agはオーム接触がよい材料である。さらに、Agは、後に形成されるITOのスパッタ法によるダメージからEL層を保護する効果もある。また、Agの膜厚が11nm以上となると光の透過率が低くなってしまうため好ましくない。Agは、成膜レートを調節することによって薄い膜厚でも密着性よく安定な膜質を得やすい材料である。また、透明導電層(ITO)が240nm未満であれば、上面からの発光と下面からの発光との透過率、反射率、および吸収率に差が生じてしまう。また、透明導電層(ITO)は、成膜時間を考慮にいれると500nmよりも薄いほうがよい。

[0033]

また、 R 、 G 、 B のそれぞれにおいて、上面からの発光と下面からの発光との透過率、反射率、 および吸収率をほぼ同一にできるのは、 A g の膜厚は 8 n m 、 透明導電層の膜厚 2 6 0 n m であり、 各層の厚さを図 2 に示す。 図 2 に示すように、 陽極側の発光は、 3 3 n m の E L 層、 1 1 0 n m の I T O 、 1 0 0 n m の 窒化珪素膜、 1 0 0 n m の アクリル樹脂、 1 0 0 n m の酸化窒化珪素膜、 1 1 0 n m の酸化珪素膜、 1 0 0 n m の窒化酸化珪素膜、 5 0 n m の酸化窒化珪素膜、 ガラス基板を順に通過するものと仮定している。 また、陰極側の発光は、 9 0 n m の E L 層、 8 n m の A g 、 2 6 0 n m の I T O 、 1 0 0 n m の 窒化珪素膜 の間にある空気は 0 n m 、 即ち、厚さがないものと 仮定している。また、図 2 の設定数値にあわせた時の透過率、反射率、および吸収率を図 3 に示す。

[0034]

以下に示す手順で多層膜のシミュレーションを行い、上記反射率と上記透過率を求めている。

[0035]

図7に示すようなN層多層膜を考えた場合、第一層からの反射率は、

【式1】

$$R_1 = (r_2 + r_1 \exp(-2i \delta_1)) / (1 + r_2 r_1 \exp(-2i \delta_1))$$

で表される。第一層をRiで表される反射率をもつ境界と見なせば、第2層からの反射率は、

【式2】

$$R_2 = (r_3 + R_1 \exp(-2i \delta_2)) / (1 + r_3 R_1 \exp(-2i \delta_2))$$

で表される。

[0036]

上記手順を最上層まで順次進めていくことによって、多層膜の反射率を得ることができる。 実際のシミュレーションでは以下の漸化式をサブルーチン化することによってプログラムを作成する。

[0037]

【式3】

$$R_{j} = (r_{j+1} + R_{j-1} \exp(-2i \delta_{j})) / (1 + r_{j+1} R_{j-1} \exp(-2i \delta_{j}))$$

$$R_0 = r_1$$
 , $\delta_i = (2\pi/\lambda)n_i d_i \cos \phi_i$

[0038]

ただし、本実施の形態でのシミュレーションでは垂直入射の場合のみを仮定したので、 cos φ , = 1 である。透過率についても同様の手順で求めることができる。透過率の漸化式は、

[0039]

【式 4】

 $T_{i} = T_{i+1} t_{j-1} \exp(-i \delta_{i}) / (1 + r_{i+1} R_{j-1} \exp(-2i \delta_{i}))$

 $T_N = t_N$, $\delta_i = (2\pi/\lambda) n_i d_i \cos \phi_i$

で表される。なお、透過率についても c ο s φ , = 1 とする。

[0040]

以上の手順により、多層膜の反射率と透過率を求めることができる。また、吸収率は、1 - (反射率+透過率)で求めることができる。

[0041]

また、ここでは金属薄膜をAgとした例を示したが、仕事関数の小さい材料、例えば、A10 1、Li、Ca、またはこれらの合金MgAg、MgIn、AlLi、CaF2、または CaNを用いることができる。また、透明電極としてITO(酸化インジウム酸化スズ合 金) と し た 例 を 示 し た が 、 酸 化 イ ン ジ ウ ム 酸 化 亜 鉛 合 金 (I n ₂ 〇 ₃ ― Z n O) 、 酸 化 亜 鉛(ZnO)、ITSO(Siを含む酸化インジウム酸化スズ合金)等を用いることがで きる。 これらの材料を用いる場合には材料の屈折率を考慮して膜厚を決定すればよい。

[0042]

ま た 、 本 発 明 は 、 3 種 類 (R , G 、 B) の E L 素 子 を 用 い て フ ル カ ラ ー 表 示 を 行 う 発 光 装 置 に 限 ら ず 、 白 色 発 光 の E L 素 子 と カ ラ ー フ ィ ル タ と を 組 み 合 わ せ て フ ル カ ラ ー 表 示 を 行 う 発 光 装 置 や 、 青 色 発 光 の E L 素 子 と 色 変 換 層 と を 組 み 合 わ せ て フ ル カ ラ ー 表 示 を 行 う 発 光装置にも適用することができる。

20

[0043]

以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行うこ ととする。

[0044]

(実施例)

[実施例1]

本実施例では、両面出射型の発光装置を図3を用いて説明する。

[0045]

図 4 (A) は 画 素 部 の 一 部 に お け る 断 面 を 示 す 図 で あ る 。 ま た 、 図 4 (B) に は 発 光 領 域 における積層構造を簡略化したものを示す。図4(B)に示すように上面と下面の両方に 30 発光を放出することができる。なお、発光領域の配置、即ち画素電極の配置としてはスト ライ プ 配 列 、 デ ル タ 配 列 、 モ ザ イ ク 配 列 な ど を 挙 げ る こ と が で き る 。

[0046]

図 4 (A) において、300は第1の基板、301a、301bは絶縁層、302はTF T、 3 1 8 が 第 1 の 電 極 (透 明 導 電 層) 、 3 0 9 は 絶 縁 物 (隔 壁 、 土 手 と も 呼 ば れ る) 、 3 1 0 は E L 層 、 3 1 1 は 第 2 の 電 極 、 3 1 2 は 透 明 保 護 層 、 3 1 3 は 空 隙 、 3 1 4 は 第 2の基板である。

[0047]

第 1 の基 板 3 0 0 上 に 設 け ら れ た T F T 3 0 2 (p チャネ ル 型 T F T) は 、 発 光 す る E L 層310に流れる電流を制御する素子であり、304はドレイン領域(またはソース領域 ・)である。また、306は第1の電極とドレイン領域(またはソース領域)とを接続する ドレイン電極(またはソース電極)である。また、ドレイン電極306と同じ工程で電源 供給線やソース配線などの配線307も同時に形成される。ここでは第1電極とドレイン 電極とを別々に形成する例を示したが、同一としてもよい。第1の基板300上には下地 絶縁膜(ここでは、下層を窒化絶縁膜、上層を酸化絶縁膜)となる絶縁層301aが形成 されており、ゲート電極305と活性層との間には、ゲート絶縁膜が設けられている。ま た、301bは有機材料または無機材料からなる層間絶縁膜である。また、ここでは図示 しないが、一つの画素には、他にもTFT(nチャネル型TFTまたはpチャネル型TF T)を一つ、または複数設けている。また、ここでは、一つのチャネル形成領域303を 有するTFTを示したが、特に限定されず、複数のチャネルを有するTFTとしてもよい 50

20

[0048]

加えて、ここではトップゲート型TFTを例として説明したが、TFT構造に関係なく本発明を適用することが可能であり、例えばボトムゲート型(逆スタガ型)TFTや順スタガ型TFTに適用することが可能である。

[0049]

また、318は、透明導電膜からなる第1の電極、即ち、EL素子の陽極(或いは陰極)である。透明導電膜としては、ITO(酸化インジウム酸化スズ合金)、酸化インジウム酸化亜鉛合金(In2O3—ZnO)、酸化亜鉛(ZnO)等を用いることができる。

[0050]

また、第1の電極 3 1 8 の端部(および配線 3 0 7)を覆う絶縁物 3 0 9 (バンク、隔壁、障壁、土手などと呼ばれる)を有している。絶縁物 3 0 9 としては、無機材料(酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなど)、感光性または非感光性の有機材料(ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジストまたはベンゾシクロブテン)、またはこれらの積層などを用いることができるが、ここでは窒化シリコン膜で覆われた感光性の有機樹脂を用いる。例えば、有機樹脂の材料としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁物の上端部のみに曲率半径を有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物として、感光性の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。

[0051]

また、有機化合物を含む層 3 1 0 は、蒸着法または塗布法を用いて形成する。本実施例では、有機化合物を含む層 3 1 0 を蒸着装置で成膜を行い、均一な膜厚を得る。なお、信頼性を向上させるため、有機化合物を含む層 3 1 0 の形成直前に真空加熱 (1 0 0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 2 5 0 $^{\circ}$) を行って脱気を行うことが好ましい。例えば、蒸着法を用いる場合、真空度が 5 × 1 0 $^{\circ}$ $^{\circ$

[0052]

なお、EL層(有機化合物を含む層) 3 1 0 は、陽極側から順に、HIL(ホール注入層 30)、HTL(ホール輸送層)、EML(発光層)、ETL(電子輸送層)、EIL(電子注入層)の順に積層する。代表的には、HILとしてCuPc、HTLとしてα-NPD、ETLとしてBCP、EILとしてBCP:Liをそれぞれ用いる。

[0053]

また、 E L 層 (有機化合物を含む層) 3 1 0 としては、 フルカラー表示とする場合、 具体的には赤色、 緑色、 青色の発光を示す材料層をそれぞれ蒸着マスクを用いた蒸着法、 またはインクジェット法などによって適宜、 選択的に成膜すればよい。

[0054]

また、上記EL層の積層構造に限定されず、緑色の発光を示す有機化合物を含む層 3 1 0 を形成する場合、 $\alpha-NPD$ を6 0 [nm] 成膜した後、同一の蒸着マスクを用いて、緑 40 色の発光層としてDMQDが添加されたAlq。を40 [nm] 成膜し、電子輸送層としてAlq。を40 [nm] 成膜し、電子強入層としてCaF2を1 [nm] 成膜する。また、青色の発光を示す有機化合物を含む層 3 1 0を形成する場合、 $\alpha-NPD$ を6 0 [nm] 成膜した後、同一のマスクを用いて、ブロッキング層としてBCPを1 0 [nm] 成膜し、電子輸送層としてAlq。を40 [nm] 成膜し、電子注入層としてCaF2を1 [nm] 成膜する。また、赤色の発光を示す有機化合物を含む層 3 1 0を形成する場合、 $\alpha-NPD$ を6 0 [nm] 成膜した後、同一のマスクを用いて、赤色の発光層としてDCMが添加されたAlq。を40 [nm] 成膜し、電子輸送層としてAlq。を40 [nm] 成膜し、電子注入層としてCaF2を1 [nm] 成膜する。

[0055]

20

30

また、白色発光として、カラーフィルターや色変換層などを別途設けることによってフルカラー表示可能な発光表示装置としてもよい。簡単な表示のみを行う表示装置、照明装置として使用する場合、単色発光(代表的には白色発光)とすればよい。例えば、ホール輸送性のポリビニルカルバゾール(PVK)に電子輸送性の1,3,4ーオキサジアゾール誘導体(PBD)を分散させてもよい。また、30wt%のPBDを電子輸送剤として分散し、4種類の色素(TPB、クマリン6、DCM1、ナイルレッド)を適当量分散することで白色発光が得られる。 また、赤色発光する有機化合物膜や緑色発光する有機化合物膜や青色発光する有機化合物膜を適宜選択し、重ねて混色させることによって全体として白色発光を得ることも可能である。

[0056]

また、311は、導電膜からなる第2の電極、即ち、発光素子の陰極(或いは陽極)である。第2の電極311の材料としては、MgAg、MgIn、AlLi、CaF2、CaNなどの合金、または周期表の1族もしくは2族に属する元素とアルミニウムとを共蒸着法により形成した透光性を有する金属薄膜を用いる。ここでは、第2の電極を通過させて発光させる両面出射型であるので、6nm~10nmのアルミニウム膜、もしくはLiを微量に含むアルミニウム膜を用いる。第2の電極311としてA1膜を用いる構成とすると、有機化合物を含む層310と接する材料を酸化物以外の材料で形成することが可能となり、発光装置の信頼性を向上させることができる。また、6nm~10nmのアルミニウム膜を形成する前に陰極バッファ層としてCaF2、MgF2、またはBaF2からなる透光性を有する層(膜厚1nm~5nm)を形成してもよい。

[0057]

また、上面からの発光と下面からの発光との透過率、吸収率、および反射率を同一とするため、および陰極の低抵抗化を図るため、6 nm~1 0 nmの金属薄膜上に透明導電膜(ITO(酸化インジウム酸化スズ合金)、酸化インジウム酸化亜鉛合金(In2O。一ZnO)、酸化亜鉛(ZnO)等)を膜厚範囲240nm~290nm、或いは380nm~500nmで形成すればよい。こうして上面からの発光と下面からの発光との表示における差をなくす。また、陰極の低抵抗化を図るため、発光領域とならない領域の第2の電極311上に補助電極を設けてもよい。また、陰極形成の際には蒸着による抵抗加熱法を用い、蒸着マスクを用いて選択的に形成すればよい。

[0058]

また、312はスパッタ法または蒸着法により形成する透明保護層であり、金属薄膜からなる第2の電極311を保護するとともに水分の侵入を防ぐ封止膜となる。透明保護層312は、スパッタ法またはCVD法により得られる窒化珪素膜、酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜(SiNO膜(組成比N>O)またはSiON膜(組成比N<O))、炭素を主成分とする薄膜(例えばDLC膜、CN膜)を用いることができる。これらの無絶縁膜は水分に対して高いブロッキング効果を有しているが、膜厚が厚くなると膜応力が増大してピーリングや膜剥がれが生じやすい。

[0059]

こうして形成された透明保護層312は、有機化合物を含む層を発光層とする発光素子の 封止膜として最適である。なお、基板間隔を確保するためのギャップ材を含有するシール 40 材によって、第2の基板314と第1の基板300とが貼り合わされている。

[0060]

また、保護層として、陰極上に第1の無機絶縁膜と、応力緩和膜と、第2の無機絶縁膜との積層からなる保護層を形成してもよい。例えば、陰極を形成した後、第1の無機絶縁膜を5nm~50nm形成し、蒸着法で吸湿性および透明性を有する応力緩和膜(有機化合物を含む層など)を10nm~100nm形成し、さらに再度、第2の無機絶縁膜を5nm~50nm形成すればよい。また、応力緩和膜と無機絶縁膜との積層を2以上繰り返し積層してもよい。

[0061]

また、本実施例では第2の基板314を構成する材料としてガラス基板や石英基板の他、

FRP (Fiberglass-Reinforced Plastics)、PVF (ポリビニルフロライド)、マイラー、ポリエステルまたはアクリル等からなるプラスチック基板を用いることができる。

[0062]

また、本実施例では、一対の基板間を空隙(不活性気体) 313 とした例を示したが、透明なシール材を一対の基板間に充填してもよい。充填するシール材としては、透光性を有している材料であれば特に限定されず、代表的には紫外線硬化または熱硬化のエポキシ樹脂を用いればよい。ここでは屈折率 1.50、粘度 500 c p s、ショア D 硬度 90、テンシル強度 300 p s i、 T g 点 150 C、体積抵抗 1×10^{-5} Q・c m、耐電圧 450 V/m i 1 である高耐熱の U V エポキシ樹脂(エレクトロライト社製: 2500 C 1 e a r)を用いる。また、透明なシール材を一対の基板間に充填することによって、一対の基板間を空間(不活性気体)とした場合に比べて全体の透過率を向上させることができる。

[0063]

また、本実施例は、実施の形態と自由に組みあわせることができる。

[0064]

[実施例2]

本実施例では、2つ以上の表示装置を備えた携帯型の電子機器の例について説明する。図5 (A) は側面図であり、図5 (B) は斜視図である。図5に示した携帯電話は、主に画像をカラー表示する高画質な第1の表示装置401と、主に文字や記号を表示する第2の 20表示装置402とを備えている。

[0065]

図 5 (A) 及び図 5 (B) に示すように、本実施例の電子機器は、第 3 の表示装置 4 0 3 を挟むように第 1 の表示装置 4 0 1 と第 2 の表示装置 4 0 2 とで開閉自在に装着した携帯型の電子機器である。なお、第 3 の表示装置 4 0 3 は、両面で表示することができるようになっている。この両面表示が可能な第 3 の表示装置 4 0 3 は、実施例 1 に従って得ることができる。

[0066]

図 5 に示した電子機器は、映像(デジタル静止画像等)を表示する第 1 の表示装置を備えた蓋部材と、タッチ入力操作部を備えた第 2 の表示装置(文字や記号等を表示する)とを 30 開閉自在に装着した携帯型の電子機器である。表示部を保護するため、図 5 に示す携帯電話は折りたたみ式になっている。

[0067]

また、第1の表示装置または第2の表示装置のうち、少なくとも一方はタッチ入力操作部を備えている。また、タッチ入力操作部を備えた画面は操作スイッチの役割をも果たしている。

[0068]

図 5 (B) 中において、 4 0 4 は操作スイッチ、 4 0 5 は音声出力部、 4 0 6 は音声入力部、 4 0 7 はアンテナである。

[0069]

また、第1の表示装置、または第2の表示装置に使用者の認証を行うセンサを備えてもよい。使用者の認証は生体情報(代表的には指紋、掌紋、声紋等)を利用すればよい。

[0070]

なお、第1の表示装置、または第2の表示装置としては、液晶表示装置あるいはEL表示 装置を用いることが可能である。

[0071]

また、本実施例は、実施の形態、または実施例1と自由に組み合わせることができる。

[0072]

[実 施 例 3]

本実施例では、両面から発光するパネルにおいて、背景が見えないようにするため光学フ 50

ィルムを用いる例を図6に示す。

[0073]

図6 (A) は発光装置の断面図を示し、図6 (B) はその斜視図を示している。外光が通過するのを防止するため、偏光板1802、1803で発光パネル1801を挟んでいる。なお、この2枚の偏光板は、光の偏光方向が直交するように配置することで外光を遮断することができる。また、発光パネル1801からの光は1枚の偏光板のみを通過するため、表示ができる。

[0074]

こうすることによって、発光して表示を行う部分以外は、黒になり、どちらの側から表示を見ても背景が透けて見えることがないものとすることができる。

10

[0075]

また、図6(A)、図6(B)では偏光板1802、1803と発光パネル1801との間隔をあけているが、特に限定されず、発光パネルに偏光板を接して設けてもよい。

[0076]

また、本実施例は、実施の形態、実施例1、または実施例2と自由に組み合わせることができる。例えば、実施例2に示した第3の表示装置403に本実施例を適用すれば、一方の面から見た場合に、背景が透けて見えて表示を認識しにくくなることを防ぐことができる。

[0077]

[実施例4]

20

30

本発明を実施して様々なモジュール(アクティブマトリクス型液晶モジュール、アクティブマトリクス型ELモジュール、アクティブマトリクス型ECモジュール)を完成させることができる。即ち、本発明を実施することによって、それらを組み込んだ全ての電子機器が完成される。

[0078]

その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ヘッドマウントディスプレイ(ゴーグル型ディスプレイ)、カーナビゲーション、プロジェクタ、カーステレオ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等)などが挙げられる。本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器の作製方法に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施の形態、実施例 1、実施例 2、実施例 3 のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

[0079]

【発明の効果】

本発明により、上面への発光および下面への発光ともに色調が均一、且つ、高品質な画像表示が両面で得られる発光装置を実現する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 E L 素子の積層モデル図である。(実施の形態)

【図2】EL素子における積層の各膜厚を示す図である。(実施の形態)

【図3】透過率、吸収率、および反射率を示した図である。(実施の形態)

40

【図4】TFTおよびEL素子を示す断面図。(実施例1)

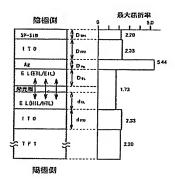
【図5】携帯型の電子機器を示す図。(実施例2)

【図 6 】 光 学 フィ ル ム を 設 け た 発 光 装 置 の 断 面 図 お よ び 斜 視 図 を 示 す 図 。 (実 施 例 3)

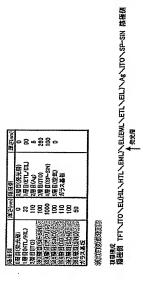
【図7】多層膜のモデル図である。(実施の形態)

【図8】色座標の比較図である。(比較例)

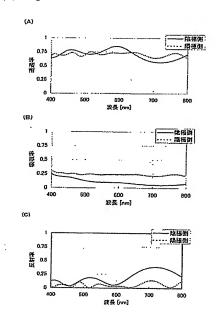
[図1]



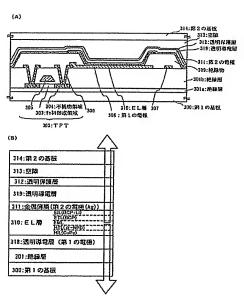
【図2】



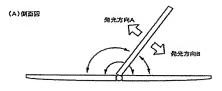
[図3]

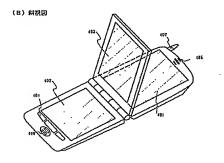


【図4】

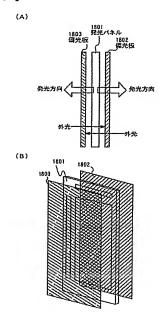


[図5]

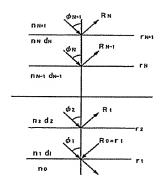




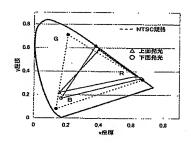
【図6】



[図7]



[図8]



フロントページの続き

Fターム(参考) 3K007 AB04 AB17 BA06 BB06 CB01 DB03